

2010 年度応用物理学会九州支部学術講演会

特別共通セミナー「化合物半導体による高機能光・電子デバイスの最前線」

日 時: 2010年11月27日(土) 13:30~16:05

場 所: 九州大学 伊都キャンパス

<プログラム>

座長 九州工業大学大学院工学研究院
電気電子工学研究系
藤原 賢三

A 会場

- Sc-1 窒化物半導体高速・パワーデバイスの最近の進展と展望 (13:30-14:15)
筑波大学名誉教授
長谷川 文夫 氏

<協賛企業講演+休憩 20分>

- Sc-2 窒化物光半導体未踏領域への挑戦 (14:35-15:05)
-InN と関連混晶の新しい成長技術と評価
立命館大学理工学部¹, 立命館大学 R-GIRO 推進機構²,
立命館大学総合理工学研究機構³, ソウル大学材料工学科 WCU プログラム⁴
名西 愷之^{1,4} 氏, 山口 智広² 氏, 王 科³ 氏, 荒木 努¹ 氏, Euijoon Yoon⁴ 氏
- Sc-3 ZnO ナノワイヤの合成とデバイス応用の最近の進展 (15:05-15:35)
九州大学大学院システム情報科学研究院 電気システム工学部門
岡田 龍雄 氏
- Sc-4 SiC 系半導体/Si のエピタキシャル成長とデバイス応用 (15:35-16:05)
九州工業大学大学院工学研究院 基礎科学研究系
中尾 基 氏